

P/1071-777

Arrangement No. 98 PA 0102

Mailing No. 242289

Mailing Date: August 14, 2001

1/2

Notice of the Reason for Rejection

Number of the Patent Application: Patent No. 221533 of 1998

Drafting Date: August 7, 2001

Examiner of the Patent Office: Junichi Imai 9055 4R00

Agent for Patent Applicant: Masahisa Nakano

Applicable Article: Article 29, Clause 2

(Date Received: August 16, 2001)

(Nakano Patent)

Deadline: October 15

This application is to be rejected for the following reason:
Should there be any opinion regarding this, please submit a Statement of Opinion (Argument) within 60 days from the date of the mailing of this notice.

Reason:

The inventions pertaining to the following claims of this application are such as could have easily been invented by the people having the ordinary knowledge in the technical field to which said inventions belong prior to said application on the basis of the inventions which were described in the following Publications 1 and 2 which had been distributed either in Japan or in a foreign country prior to said application.

Accordingly, they are not to be granted patents pursuant to the stipulations contained in Article 29, Clause 2 of the Law of Patents.

Note:

(Pertaining to Claims 1, 2 and 3)

1. Official Publication of Toku Kai Hei 2-121350

(Descriptions on line 11 in the lower left-hand column on page two through line one in the upper left-hand column on page four: Correspond to an electronic device wherein a lower-layer

electrode made of a material which is capable of reactive ion-etching is formed with a gas of the fluorine system and an upper layer electrode made of a material which is capable of reactive ion etching is formed with a gas of the chlorine system.)

2. Official Publication of Toku Kai Hei 8-264508

(Paragraphs 21 through 34: Corresponds to a single crystalline substrate or a single crystalline film or a triple-axis orientation film or a single axis orientation film.)

Remarks:

Cited Example 1 describes a foundation where the W film is formed and, even though the single crystal substrate or a single crystal film or a triple-axis orientation film or a monoaxial orientation film is not mentioned, Cited Example 2 describes the fact that, in connection with the forming of the Al film on such a foundation, followed by etching, the gases should be switched so as to avoid any possible effect upon the foundation layer.

Accordingly, to employ the technique of laminating the W film and the Al film and switching the chlorine to fluorine for the purpose of preventing the possible effect upon the foundation layer, followed by etching as described in Cited Example 1 onto the single crystalline substrate or a single crystalline film or a triple-axis orientation film or a mono-axial orientation film as described in Cited Example 2 is believed to be something that the people in the industry could suitably carry out.

No reason for rejection has yet been found at this time regarding the invention pertaining to Claim 4 other than those claims which have been pointed out in this Notice of the Reason for Rejection. Should a reason for rejection be found anew, such a reason for rejection shall be notified to you.

--

Record of the Result of a Survey on Prior Technical Literature.

Field Covered in the Survey:

IPC Seventhth Edition H 01 L 21/3065

H 03 H 3/08

This record of the result of a survey on prior technical literature does not constitute any reason for rejection.

整理番号 98PA0102

発送番号 242289

発送日 平成13年 8月14日 1 / 2

拒絶理由通知書

10/13

特許出願の番号

平成10年 特許願 第221533号

起案日

平成13年 8月 7日

特許庁審査官

今井 淳一

9055 4R00

特許出願人代理人

中野 雅房

様

適用条文

第29条第2項



期限
10/15

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から60日以内に意見書を提出して下さい。

理 由

この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記1、2の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記

【請求項1、2、3に対して】

1、特開平2-121350号公報

(第2頁左下欄第11行～第4頁左上欄第1行:フッ素系ガスで反応性イオンエッチング可能な材質からなる下層電極を形成し、当該下層電極の上に、塩素系ガスで反応性イオンエッチング可能な材質からなる上層電極を形成した電子デバイスに相当する点)

2、特開平8-264508号公報

(第21～34段落:単結晶基板または単結晶膜または3軸配向膜または1軸配向膜に相当する点)

続葉有



続 葉

備考

引用例1においてはW膜が形成される下地について、単結晶基板または単結晶膜または3軸配向膜または1軸配向膜ではないが、引用例2においては、そのような下地の上にA1膜を形成してドライエッチングする際に、下地層に影響のないようにガスを切替えるべきことが記載されているから、引用例1に記載の、下地膜への影響を防ぐためにW膜とA1膜を積層し、塩素からフッ素に切替えてエッチングする技術を引用例2記載の単結晶基板または単結晶膜または3軸配向膜または1軸配向膜上に用いることは当業者が適宜なし得た事項であると認められる。

この拒絶理由通知書中で指摘した請求項以外の請求項4に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

 先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野 IPC第7版 H01L21/3065
 H03H 3/08

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。